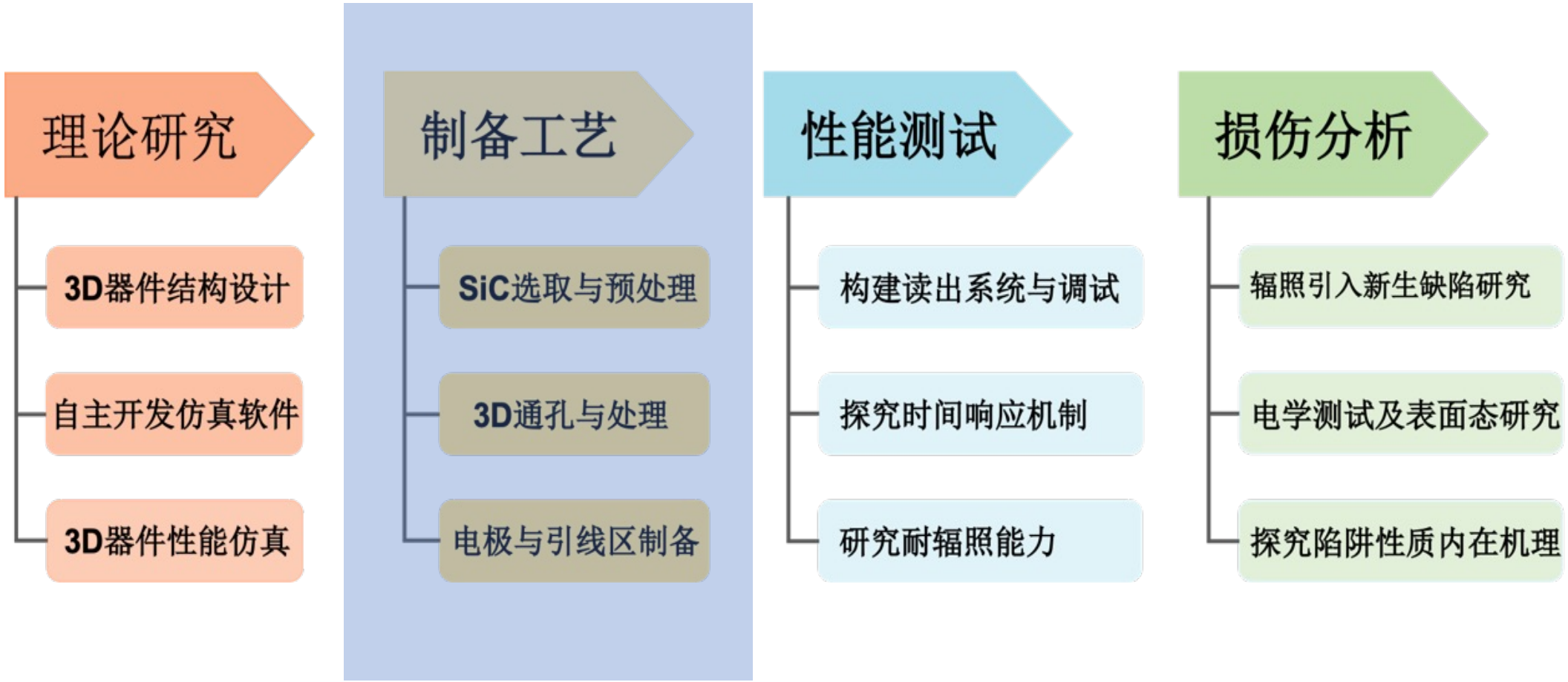
碳化硅探测器 – 制备工艺

史欣

2022年9月2日

技术路线


理论研究
3D器件结构设计
自主开发仿真软件
3D器件性能仿真
制备工艺
SiC选取与预处理
3D通孔与处理
电极与引线区制备
性能测试
构建读出系统与调试
探究时间响应机制
研究耐辐照能力
损伤分析
辐照引入新生缺陷研究
电学测试及表面态研究
探究陷阱性质内在机理

会议日程


9:00 AM → 9:05 AM 制备工艺
Speaker: Xin Shi (IHEP)
9:05 AM → 9:35 AM 半导体刻蚀工艺
Speaker: 晓川 夏 (Dalian University of Technology)
9:35 AM → 9:40 AM AOB